

2024 年度

ウェスタンデジタル半導体女性人材育成奨学金

募集要項

1. 趣旨・目的

本支援は、ウェスタンデジタル(WD)合同会社から名古屋大学最先端半導体研究戦略室への寄附を財源とした給付型奨学金です。半導体女性人材の育成を目的とした、半導体技術に関心を持つ、学業成績優秀な女子学生の修学環境の向上および研究活動を支援・奨励するものです。

2. 申請資格

奨学金の申請資格は、次の各号に該当する者とします。

- (1) 名古屋大学工学部 3 年次に在学する女子学生。
- (2) 学業成績が優秀である者。学業基準は別表 1 の基準を満たす者。
- (3) 半導体技術に強い関心を持つ者。半導体の技術・産業動向を注視し、将来、直接・間接的に半導体に関係する分野で活躍したいと考えている者。
- (4) 申請時または申請にかかる学期の開始前 6 ヶ月以内に名古屋大学通則第 3 4 条の規定による懲戒処分を受けていないこと及び処分中でないこと。

3. 奨学金給付額・給付期間

給付額は月額 5 万円で、給付期間は 2024 年 10 月から 2025 年 3 月の半年間とします。2025 年 4 月に継続審査を行います。別表 1 の基準を満たし、提出されたレポートを審査のうえ、合格と認められた者には、さらに 1 年間給付を行います。奨学金は半年毎に半年分を一括で給付します。

4. 募集人数

2 名程度

5. 募集対象

半導体技術に強い関心を持ち、半導体の技術・産業動向を注視し、将来、直接・間接的に半導体に関係する分野で活躍したいと考えている、工学部 3 年次に所属する女子学生が対象です。工学部の全学科が対象となります。

(電気電子情報工学科、物理工学科、マテリアル工学科、エネルギー理工学科で半導

体材料やデバイスなどの研究室を目指している学生は対象となりますが、それに限定されません。機械・航空宇宙工学科、化学生命工学科、環境土木・建築工学科も対象となります。例えば、半導体技術のそれぞれの分野での応用技術、あるいは、半導体産業にそれぞれの分野がどのようにかかわっているかなどに関心を持つ者も対象となります。)

6. 受給者の義務

(1) 良好な成績を保つこと。(別表1)

(2) 各年度末にレポートを提出すること。レポートは、簡単な活動報告と課題からなります。課題については以下の3つから、2つを選び提出すること。(あるいは、1つに対して2件実施しても良い。例えば、書籍2冊を読むなど。)詳細は採択者に個別にお知らせします。

1. 半導体関係の書籍を1冊読んだ感想文。
2. 新聞、ニュース、日経エレクトロニクス(名古屋大学電子図書館で閲覧可能です)などを参考にして、半導体関係の技術動向に関するレポート。
3. 学内で開催される半導体に関する講演会に参加し、その講演に関するレポート。

7. 申請・審査・採用の流れ

(1) エントリー方法

2024年11月8日(金)正午までに、Microsoft365のFormsで申請して下さい。Formsの利用には機構アカウントによるMicrosoft365へのログインが必要です。Formsでは、600字程度の課題作文と2024年10月時点での成績証明書の写し※を提出して頂きます。課題作文の内容(テーマ)はMicrosoft365 Formsに掲載してあります。

Microsoft365 Forms : <https://forms.office.com/r/cAGTUa4uj5>

※スキャン、もしくはスマートフォン等で撮影した画像をアップロード(PDFを推奨)し、スキャンデータには必ずパスワード(学生番号9桁)を設定して下さい。



(2) 一次審査

学業成績と課題作文で一次審査を実施し、一次審査通過者を決定します。結果は11月18日（月）までに通知します。

(3) 二次審査

下記の課題書籍を読んで11月25日（月）正午までにレポートを提出して頂きます。（レポートの詳細は一次審査通過者に個別にお知らせします。）課題書籍は希望者には貸し出し可能です。提出して頂いたレポートを元に面接審査を行います。

課題書籍

タイトル：半導体産業のすべて 世界の先端企業から日本メーカーの展望まで

著者：菊池正典

出版社：ダイヤモンド社

ISBN：978-4-478-11711-8

範囲：第1章から第3章まで

(4) 採択結果の通知

11月末までに通知します。採択確定後に、改めて手続き書類や銀行口座への振り込み書類等の連絡をします。10月1日から3月31日の6か月分の金額を支給します。

8. 注意事項

- (1) 本奨学金は半導体に関心を持つ女子学生の育成を支援するものであって、その進路を制限するものではありません。卒業研究の配属先として、半導体に関する研究室への配属を義務付けたり、進路や就職先に制限を設ける等のことは一切ありません。
- (2) 本奨学金は返済義務がありません。
- (3) 半導体関連企業からのインターンシップやセミナーおよび関連イベント等の案内が届くようになりますが、返答・参加は必須ではありません。興味があるものについて参加いただければと思います。なお、インターンシップやセミナー等に参加しなくても継続審査に不利になることは一切ありません。
- (4) 他の奨学金との重複支給は可能ですが、先方が重複支給を禁じている場合がありますので確認してください。先方の奨学金の方が有利でそちらを受給したい場合は、本奨学金を辞退することもできます。
- (5) 受給中に休学する場合は、事前に申し出て下さい。休学中は給付が停止されます。
- (6) 次の場合は、受給資格を失います。

1. 退学（除籍、死亡を含む）により学籍を失った場合
 2. 名古屋大学通則第34条の規定による懲戒処分を受けた場合
 3. 奨学生の義務を怠る等、奨学生として不適当であると認められる場合
- (7) 提出書類における虚偽の記載やこの募集要項に記載する事項に違反する場合など不適切な事実が判明した場合、受給した奨学金の全部や一部を返納していただくことがあります。

問い合わせ先

名古屋大学 学内コンソーシアム 最先端半導体研究戦略室内
ウエスタンデジタル半導体女性人材育成奨学金担当係

質問などは

最先端半導体研究戦略室・特任助教 ノルジン ドラムジャブ

Tel : 052-789-3168

E-mail : norjin.dulamjav.j7@f.mail.nagoya-u.ac.jp

最先端半導体研究戦略室 副室長

工学研究科電子工学専攻・教授 牧原克典

Tel : 052-789-3588

E-mail : makihara@nuee.nagoya-u.ac.jp

(表1) 成績評価基準

学部年次	基準
3年次	学部3年次春学期の成績を含む学業成績の累積 GPA が 3.0 以上の者
4年次	学部3年次秋学期の成績を含む学業成績の累積 GPA が 3.0 以上の者